

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора Головного
органа ГССО

И.Е. Добровинский
05 " 07 2000 г.
МП

Стандартный образец комплексной
диэлектрической проницаемости
(стеклотекстолит), СОКДП

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер 2531-83

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: ТУ "Стандартные образцы комплексной диэлектрической проницаемости, относительной диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь", утверждены 25.02.2000 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ГСО предназначен :

- для поверки, калибровки и градуировки средств измерений комплексной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот 0.2-1.0 ГГц (типа ИПДП, КР-500 и др.), используемых в приборостроении, химической, радиотехнической, электронной промышленности;
- для метрологической аттестации методик выполнения измерений комплексной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот 0,2-1,0 ГГц.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:

- на методы измерений ГОСТ 8.358-79
- на методы поверки ГОСТ 8.274-85

ОПИСАНИЕ: ГСО изготовлены в форме диска диаметром 30 и 50 мм, толщиной 0,1-2,0 мм из материала стеклотекстолит ГОСТ 10292-74.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**Аттестуемые характеристики :**

- относительная диэлектрическая проницаемость должна находиться в интервале $4,30 - 4,46$
- тангенс угла диэлектрических потерь должен находиться в интервале $(1,35 - 1,65) \cdot 10^{-2}$

Аттестованные значения определены в диапазоне частот $\sim 0,2-1,0$ ГГц

Граница допускаемого значения относительной погрешности аттестованного значения при доверительной вероятности 0,95 :

- для относительной диэлектрической проницаемости $\sim 1,5 \%$
- для тангенса угла диэлектрических потерь $\sim 10 \%$

Срок годности экземпляра СО или периодичность контроля: аттестация в СНИИМ 1 раз в два года

РАЗРАБОТЧИК СО: Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии - СНИИМ, 630004, г. Новосибирск-4, пр.Димитрова,4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: СНИИМ, 630004, г. Новосибирск-4, пр.Димитрова,4

Зам. директора СНИИМ



В.Ф. Матвейчук

Кур